







| 1998年                    | 2006年                      | 2008 <b>年</b>             | 2013 <b>年</b>             | 2016 <b>年</b> | 現在                   |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| PET装置・サイク<br>ロトロン導入      | 未来創業・医療イノペー<br>ション拠点形成事業開始 | PET/CT装置導入                | PET装置更新、<br>PET/CT装置追加導入  |               |                      |
| "EXACT HR+"<br>(Siemens) |                            | +                         | "Gemini TF"<br>(Philips)  |               | •••••                |
| "EXACT 47"<br>(Siemens)  |                            | +                         | "Gemini GXL"<br>(Philips) |               | •••••                |
|                          | 研究用半導体PET<br>(北大,日立)       |                           |                           |               |                      |
|                          |                            | "Biograph64"<br>(Siemens) |                           |               | +                    |
|                          |                            |                           |                           |               | "Vereos<br>(Philips) |
|                          |                            |                           |                           | HO            | KKAID                |



![](_page_0_Picture_7.jpeg)

![](_page_0_Picture_8.jpeg)

![](_page_0_Figure_9.jpeg)

![](_page_1_Picture_1.jpeg)

![](_page_1_Figure_2.jpeg)

![](_page_1_Figure_4.jpeg)

![](_page_1_Figure_5.jpeg)

![](_page_1_Picture_6.jpeg)

![](_page_1_Figure_7.jpeg)

| 半導体とは  |                                     |          |                  |        | 15                   |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------|
| 半導体の種類   | 半導体検出器に用いられる                        | 半導体の性    | 生質               |        |                      |
| <ol> <li>単元素半導体         <ul> <li>✓ Si. Geなど</li> </ul> </li> </ol> | @25°C                               | Si       | Ge               | CdTe   | CZT                  |
| 2. 化合物半導体  | 原子番号                                | 14       | 32               | 48, 52 | 48, 30, 52           |
| ✓ Colle, Colle (C21), 2nS, GaAs<br>3. その他                          | 密度 (g/cm3)                          | 2.33     | 5.33             | 6.2    | 6.0                  |
| ✓ カーボンナノチューブ ✓ 導雷性ポリマー(高分子半導体)                                     | バンドギャップエネルギー (eV)                   | 1.12     | 0.67             | 1.44   | 1.5-2.2              |
| 定義:  | キャリア対生成エネルギー (eV)                   | 3.62     | 2.96             | 4.43   | 5.0                  |
| 何らかの手段を用いることで電子の流れを<br>自由に制御できること                                  | 比抵抗 (Ωcm)                           | 104      | 50               | 10º    | 1011                 |
| 日田に前時でとうこと   | 電子移動度 (cm²/Vs)                      | 1400     | 3900             | 1100   | 1350                 |
| 半導体の主な用途   | 正孔移動度 (cm <sup>2</sup> /Vs)         | 480      | 1900             | 100    | 120                  |
| ✓ トランジスタ、集積回路 ✓ 発光ダイオード、フォトダイオード(受光素子)                             | 電子寿命 (sec)                          | 10-3     | 10-3             | 3×10-6 | 10-5                 |
| ✓ 太陽電池<br>など   | 正孔寿命 (sec)                          | 2 × 10-3 | 10 <sup>-3</sup> | 2×10-6 | 5×10-8               |
|  |                                     |          |                  |        |                      |
| Schlesinger, James. Semiconductors for room temperature nuclea     | r detector applications. Vol43:p471 | D.       |                  | HOK    | KAIDO<br>e r s i t y |

![](_page_1_Figure_9.jpeg)

![](_page_1_Figure_10.jpeg)

![](_page_2_Picture_1.jpeg)

![](_page_2_Picture_2.jpeg)

![](_page_2_Picture_4.jpeg)

半導体の用途 ~Silicon Photomultiplier (SiPM)~ Analog-SiPM GE Siemens PET装置への実装 "Discovery MI" "Biograph Vision ✓ 複数のシンチレータを1つのanalog-SiPMでカバー (両メーカ共に4×4=16個のクリスタルに1個の \_ クリスタル Analog-SiPM?) →PMTと同じ →アンガーロジック(重心計算)が必要 →重心が偏る(信号に偏心がある) ✓ アナログ信号に起因するノイズがある →ヒートノイズ、電気的なノイズ Analog-SiPM ightburst Digital Detector. GE Healthcare white paper. ANM'18. 機器展示. Siemens booth. HOKKAIDO 21

![](_page_2_Figure_6.jpeg)

![](_page_2_Figure_7.jpeg)

![](_page_2_Figure_8.jpeg)

![](_page_2_Figure_9.jpeg)

![](_page_2_Figure_10.jpeg)

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

|                                     |                  | Philips<br>"Vereos"    | Philips<br>"Gemini TF" | Siemens<br>"Biograph Vision" | GE<br>"Discovery MI"                       |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| 光検出器                                |                  | Digital-SiPM           | PMT                    | Analog-SiPM                  | Analog-SiPM                                |
| Axia                                | FOV (cm)         | 16.4                   | 18.0                   | 26.1                         | 15 (3 ring) / 20 (4 ring)                  |
| Transve                             | rse FOV (cm)     | 67.7                   | 67.6                   | 70                           | 70   |
| クリスタルサイズ (mm³)                      |                  | 4.0 × 4.0 × 19         | 4.0 × 4.0 × 22         | 3.2 × 3.2 × 20               | 3.95 × 5.3 × 25                            |
| TOF時間分解能 (psec)                     |                  | 310                    | 495                    | 214                          | 375.4                                      |
| 空間分解能*1                             | Transverse @1 cm | 4.2                    | 4.8                    | 3.5                          | 4.2  |
| (mm FWHM)                           | Axial @1 cm      | 4.2                    | 4.8                    | 3.5                          | 4.5  |
| 感度 @center (cps/kBq)                |                  | 5.1                    | 6.6                    | 16.4                         | 7.5 / 13.7                                 |
| Peak NECR (kcps) @activity (kBq/mL) |                  | 153 kcps<br>@55 kBg/mL | 125 cps<br>@17 kBq/mL  | 306 cps<br>@33 kBq/mL        | 100 kcps @21 kBq/mL<br>193 kcps @22 kBq/mL |
| 赦乱フラクション (%)                        |                  | 33.9                   | 27                     | 38.7                         | 40.6                                       |

Kol Var He

![](_page_3_Figure_4.jpeg)

![](_page_3_Figure_5.jpeg)

![](_page_3_Figure_6.jpeg)

Time-of-flight Non-TOF TOF 650 psec (∠x = 9.7 cm) 500 psec (⊿x = 7.5 cm) 200 psec (∠lx = 3.0 cm) Ċ., ⊳ 1.0 2.0 2.3 3.7 SNR gain NEC gain (Sensitivity gain) 13.3 1.0 4.1 5.3 ※被写体直径を40 cmと過程 画像再構成法: FBF linical implementation of VUE Point FX<sup>™</sup>. GE Healthcare white paper.を改变 HOKKAIDO 32

![](_page_3_Figure_8.jpeg)

![](_page_3_Figure_9.jpeg)

![](_page_3_Figure_10.jpeg)

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

![](_page_4_Picture_2.jpeg)

![](_page_4_Figure_3.jpeg)

| 半導                | 体素子を搭載したPET装置により   | 期待できること 39  |
|-------------------|--|---|
| - 일<br>- T<br>- ở | 空間分解能の向上<br>TOF時間分解能の向上(実効感度、実<br>数え落としの低減(計数率直線性の改<br>応用例<br>- 診断精度の向上<br>- 精度の良い放射線治療計画<br>- 繰り返し検査への対応<br>- (正確な治療効果判定) | 効SNRの上昇)<br>善)<br>これまでの知見(主に北大<br>で行われた研究)をもとに<br>Vereosへの期待を考察 |
|                   |  |   |
| 39                |  |   |

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

![](_page_4_Picture_7.jpeg)

![](_page_4_Figure_8.jpeg)

![](_page_4_Picture_9.jpeg)

![](_page_4_Picture_10.jpeg)

| 精度の良い放   | 射線治療計画   |                                      |   | 45                                      |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Patient $\overline{\texttt{bis}}$ Average $\pm$ SD     1: $p$ value     1: | 型半導体PET 《 従来型F<br>5.7 ± 9.9 mL<br>0.0006 34.0 ± 20 | PET 高分解<br><u>3.5 mL</u> 治療にな<br>なった | 能のPETを用いること <sup>-</sup><br>おける標的体積が有意            | で、放射線<br>に小さく                           |
| Patient no.<br>Average $\pm$ SD<br><i>p</i> value                          | 大級・小編線<br>直接型半導体PET<br>2.001 ± 347<br>0.0418       | 量 (cGy)<br>従来型PET<br>2.233 ± 209     | 総幹統員<br>直接型半導体PET<br><u>1.475 ± 612</u><br>0.0041 | L (cGy)<br>従来型PET<br><u>1.816 ± 455</u> |
| 高分解能のPET<br>脳組織の線量を  | を用いることで、標的<br>減らすことができた                            | 外                                    |   |   |
| Katoh N, et al. Int J Radiation  | Oncology Biol Phys. 2012;82:e67                    | 1–6.                                 | ()  | HOKKAIDO                                |

![](_page_5_Picture_2.jpeg)

![](_page_5_Figure_4.jpeg)

![](_page_5_Picture_5.jpeg)

繰り返し検査への対応 90 sec/bed - Vereos - <sup>89 kg</sup> - <sup>10</sup>F-FDG (477 MBq) - <sup>10</sup>F-FDG (477 MBq

![](_page_5_Figure_7.jpeg)

 本日の内容
 51

 ・ 北大PET装置の発達
 ・ 次来型PET装置のおさらない

 ・ 火来型PET装置のおさらない
 ・ 1

 ・ 米市林 とその用道 1 1
 ・ 1

 ・ 北大での航界街堂とまとめ
 ・ 0

 ・ 北大での航界街堂とまとめ
 ・ 1

 ・ 北大での航界街台とまとめ
 ・ 1

![](_page_5_Figure_9.jpeg)

| 空間分解能G =                         | $= 1.25\sqrt{(d/2)^2 + s^2 + (0.0044H)^2}$     | $(x)^2 + b^2$ | $+\frac{(12.5r)^2}{r^2+R^2}$ | (mm FW    | 'HM)              |
|----------------------------------|--|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| Decoding error                   |  | 空間分解的         | 能(NEMA)                      |           | Di-14-1 010       |
| PMT搭載PETにおけるアンガーロジック<br>を用いた位置演算 | クリスタルとDigital-SiPM大きさが一致(1:1カップリング)<br>→位置演算不要 | (mm FWHM)     |                              | Philips   | Philips<br>Verene |
|                                  |  |               | @ 1 cm                       | 4.7       | 4.0               |
|                                  |  | Transaxial    | @ 10 cm                      | 5.2       | 4.5               |
|                                  |  | Avial         | @ 1 cm                       | 4.7       | 4.0               |
|                                  | ※Philos "Vereos"のみの構造                          | Axial         | @ 10 cm                      | 5.2       | 4.5               |
|                                  |  |               |                              | жi        | 而像再構成法: F         |
|                                  | ※Philips "Versos"のみの構造                         |               | @ 10 cm                      | 5.2<br>*i | 4.5<br>画像再横成法     |

51

![](_page_6_Figure_1.jpeg)

![](_page_6_Figure_2.jpeg)

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

![](_page_6_Figure_4.jpeg)

![](_page_6_Figure_5.jpeg)

![](_page_6_Figure_6.jpeg)

![](_page_6_Figure_7.jpeg)

![](_page_6_Figure_8.jpeg)

![](_page_6_Figure_9.jpeg)

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

![](_page_7_Picture_2.jpeg)

![](_page_7_Figure_4.jpeg)

 Take home message
 ガンマ線を直接検出するタイプとシンチレータを介して間接的に検出す るタイブの半導体PET装置がある(ただし、商用化しているのは間接 型のみ)
 Silicon Photomultiplier (SiPM)には、信号をアナログ出力するタイプ とデジタル出力するタイプがある
 SiPM搭載PETIは、空間分解的向上、数え落としの低減、TOF効果 の上昇などが期待できる
 →提昇などが期待できる
 →提与量(被曝)を減らし、繰り返し検査ができる
 →撮影時間を減らし、編みの強い患者の負担を減らす(アーチファクト低減)
 →投与量、撮影時間はそのままに、より画質を上げる

![](_page_7_Picture_8.jpeg)

![](_page_7_Picture_9.jpeg)

![](_page_7_Picture_10.jpeg)

67